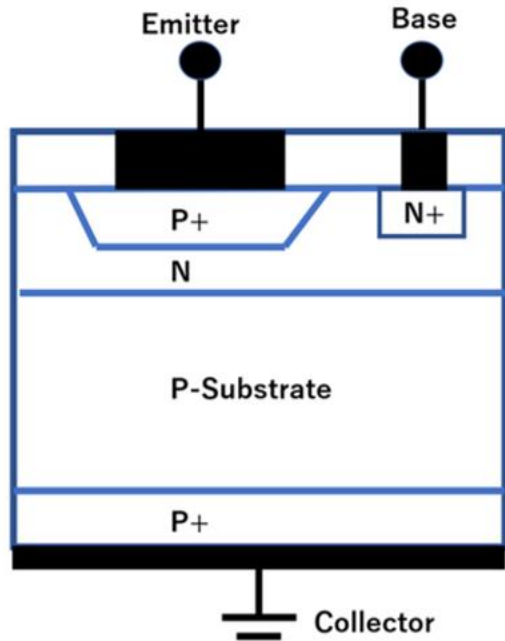


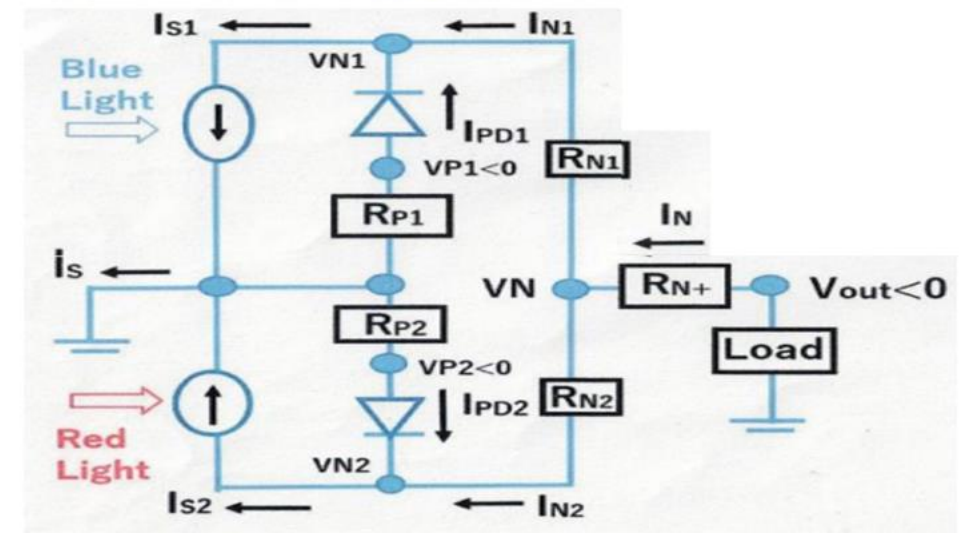
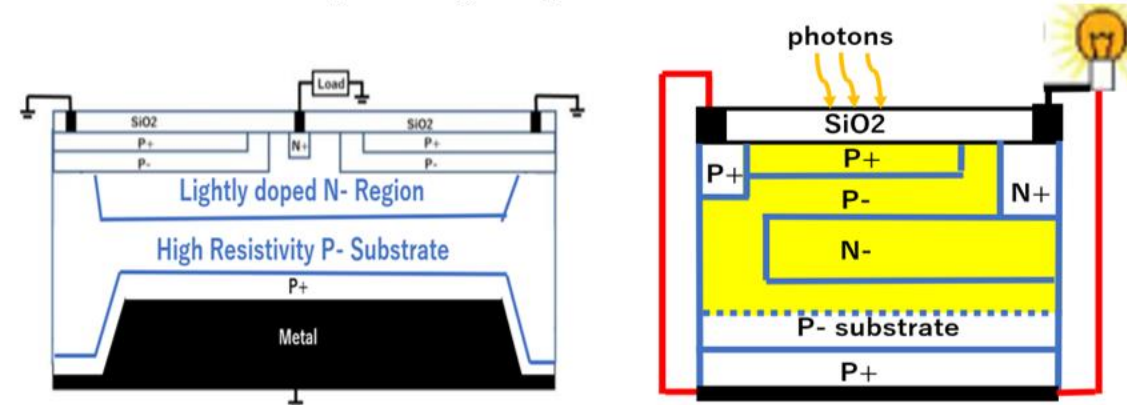
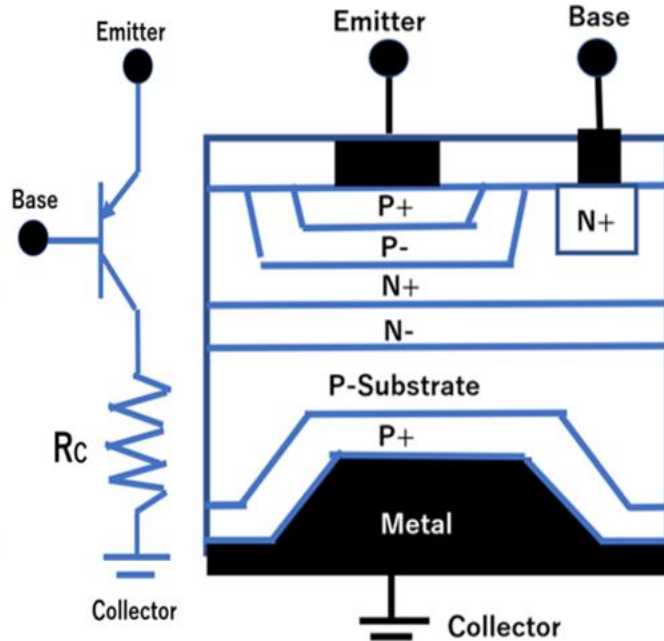
SonyのP+P-N-P-P+ Double 接合Pinned Photodiode 型太陽電池は、もともと1950年代に開発され実用化された世界一性能の良いSonyのBipolar Transistor技術をヒントに考案されたものです。超光感度の受光素子です。高い量子変換効率で光エネルギーを電気エネルギーに変換できます。

Double Junction Pinned Photodiode type Solar Cell was hinted by Sony Bipolar Transistor.

Bell Lab 1948 Bipolar Transistor



Sony Bipolar Transistor



世界一性能の良いSonyのBipolar Transistor技術はSonyの川名喜之の発明により基板を薄くし、Collector端子の拡散抵抗値を低減する事により実現しました。

JPA2000-131313